* IGBT (INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTOR)

# C:\Users\n1-07\Desktop\sketch1538985179098.png

Evropski način označevanja polprevodnika

# DIN, IEEC, YUS

2/3 črke BC107B

2/3 števila BSY85

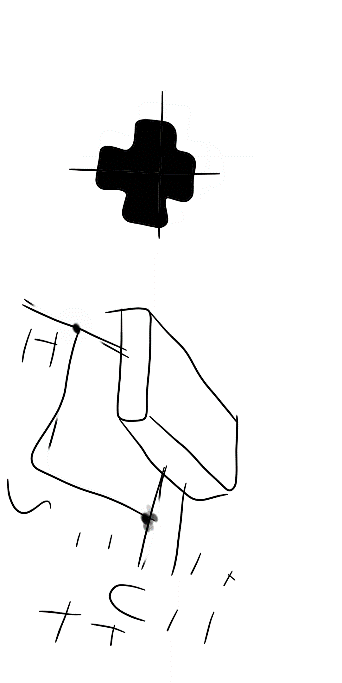
Pomen 1. črke

1. germanij 0.1V
2. silicij 0,6v

CuSu (ostali materjali)

# POMENDRUGE ČRKE

1. Vse šibke diode <1w (točkaste, planarne, epikasjalne,…) AA113
2. VARICAP- dioda (kapacitivna dioda) BB104
3. N.F. tranzistor <<1w BC107B
4. Nizkofrekvenčni tranzistor >>1W BD140
5. Tunelska dioda GUN-DIODA
6. VISKOKO frekvenčni tranzistor <1w BF238
7. NI
8. HALL-sonda magnetni polprevodni material BH100



L- V.F. močnostni tranzistor BL100

P- FOTO POLPREVODNE diode, tranzistor, tiristorji,… BP100-> I.R.; U.V.

R- tri-slojni, štiri-slojni prožilni element <1W

S- stikalni swich tranzistor male moči <1W BS90

T- tri-slojni, večslojni močnostni elementi >>1W triaki, tranzistorji,… BT406 (40V 6A)

U- Močnosti stikalni tranzistor >>1W

X- polprevodni občutlivi na atomska sevanja (α, β, γ, δ, X-RAY)

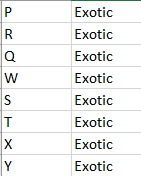
Y- Usmerna dioda >0,5A… BY238

Z- Zener dioda ZTF… ZTK… BZX53C6V8

BZY56C7V5

# POMEN 3. ČRKE

1. IZBOLŠAVE

IZBOLŠAVE NEKATERE LASTNOSTI (U, I, f, t,) ns ohišje [BDX53C]

1. DODATNE ČRKE (primeri)

BC107

BC107AP-plastik

* BC107 A 125/250

B > SORTIRANI 240/500 }ojačanje hfe β

C 450/900

* BDX53 A 60V
  + B 80V
  + C 100V
  + D 120V

1. 2N3055: (I, II, III, IV, V,…)

AMERIŠKI STANDARDNI NAČIN

1NXXXX VSE DIODE (šibke, močne, hitre, pametne, PIN, SCHOTTKY)

(0-9) na X

Višja številka znotraj grupe je BOLŠI element 1N400 100V

1N4007 1000V

1N4007 S 1200V (S je SUPER)

2NXXXX vsi tranzistorji PNP, NPN

SUHI, DEBELI, ŠIBKI, MOČNI

Bipolarni; in nekateri MOSFET FET

3NXXXX VSI OSTALI FOTO MOSFET UJT, IGRT,

4NXXXX TRIAC, TIRIS -EXOTIKA

5NXXXX

JAPONSKI STANDARDNI NAČIN

1SAxxxx VSE DIODE

2SAxxxx

2SBxxxx > PNP ŠIBKI/MOČNI

2SCxxxx

2SDxxxx >NPN ŠIBKI/MOČNI

2SJ^xxxx MOSFET,FET

2SK^xxxx N. KONLI FET